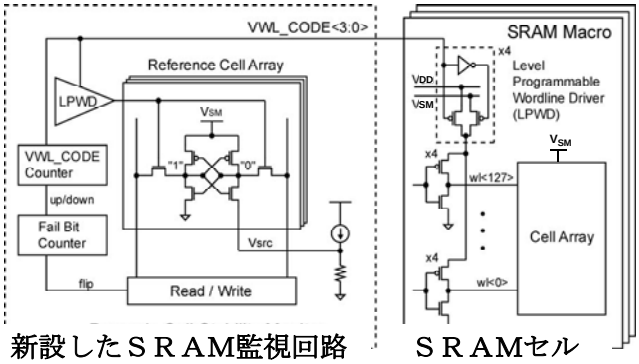
（別紙）今回開発した技術の概要

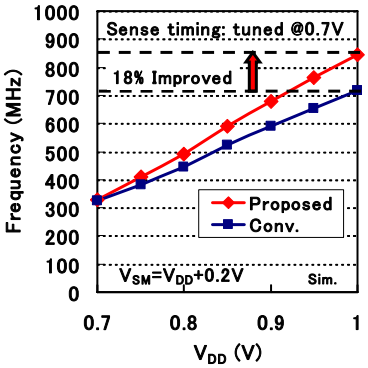
１．SRAM の記憶セルの特性を監視する回路



新設したＳＲＡＭ監視回路　　ＳＲＡＭセル

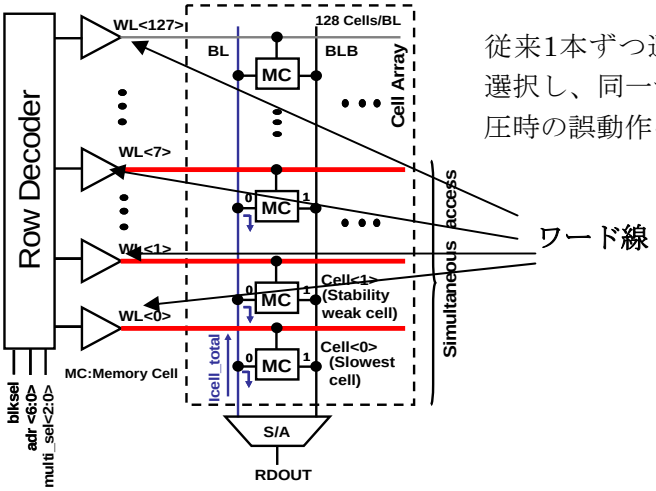
ＳＲＡＭの記憶セルの特性を監視する回路を新設することで、電圧や温度など、動作条件が変化してもワード線の電圧を変動させることで、安定動作を実現する。

２．メモリの読み出しタイミングを最適化したことによる高速化の効果



電圧が大きくなればなるほど、高速化の効果が大きくなり１．０Ｖ時に従来比１８％の高速化を実現する。

３．複数セルに同一データを読み書きすることで、SRAM セルを低電圧で動作させる技術



従来1本ずつ選択していたワード線を8本同時に選択し、同一データを読み書きすることで、低電圧時の誤動作を防ぐ。